

## СОДЕРЖАНИЕ

## МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ МНСТ

- Жуков Д. А., Куприянова М. А., Мокринский Ю. И., Амеличев В. В., Костюк Д. В., Васильев Д. В., Орлов Е. П.** Влияние конструктивных параметров на электрофизические характеристики анизотропных магниторезистивных преобразователей магнитного поля с полюсами барбера . . . . . 579

## МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МНСТ

- Васильев В. Ю.** Технологии получения тонких пленок нитрида кремния для микроэлектроники и микросистемной техники Часть 4. Процессы в проточных реакторах с активацией плазмой высокой плотности . . . . . 585
- Борисенков И. Л., Еремин Р. А., Крутов А. Ф., Медриш И. В.** Особенности применения геометрико-топологического анализа при поиске новых магнитоотрицательных материалов для гибридных оптоволоконных датчиков на брэгговских решетках . . . . . 595

## ЭЛЕМЕНТЫ МНСТ

- Егоренков В. М., Прудников Н. В., Чернов В. А.** Миниатюрные наноструктурированные источники тока на основе прямого преобразования ядерной энергии . . . . . 606
- Кульчицкий Н. А., Наумов А. В., Старцев В. В.** Неохлаждаемые микроболометры инфракрасного диапазона — современное состояние и тенденции развития . . . . . 613
- Пятьшев Е. Н., Эннс Я. Б., Акульшин Ю. Д., Одинцов А. В.** Тонкопленочный электромеханический оптический затвор . . . . . 625
- Рембеза С. И., Овсянников С. В., Буслов В. А., Рембеза Е. С., Кошелева Н. Н., Свистова Т. В.** Газовая чувствительность при комнатной температуре полевого транзистора с металлооксидным каналом . . . 633

Аннотации и статьи на русском и английском языках доступны на сайте журнала (<http://microsystems.ru>; <http://novtex.ru/nmst/>) в разделе "Архив статей с 1999 г."

## ПОДПИСКА:

по каталогу "Пресса России" (индекс 27849)  
в редакции журнала (тел./факс: (499) 269-55-10)

Адрес для переписки:  
107076 Москва,  
Стромьинский пер., д. 4  
e-mail: nmst@novtex.ru

Учредитель:

Издательство "Новые технологии"